法政大学学術機関リポジトリ

HOSEI UNIVERSITY REPOSITORY

PDF issue: 2025-06-07

リチウムニ次電池正極材料 Li_5 SiN_3の結 晶作成と物性評価

TAKEUCHI, Yusaku / 竹内, 優作

(出版者 / Publisher) 法政大学大学院理工学・工学研究科

(雑誌名 / Journal or Publication Title)

法政大学大学院紀要.理工学・工学研究科編 / 法政大学大学院紀要.理工学・工 学研究科編

(巻 / Volume)
57
(開始ページ / Start Page)
1
(終了ページ / End Page)
4
(発行年 / Year)
2016-03-24
(URL)
https://doi.org/10.15002/00013043

リチウム二次電池正極材料Li₅SiN₃の 結晶作成と物性評価

$\label{eq:synthesis} SYNTHESIS AND PHYSICAL PROPERTIES OF LI_5SIN_3 \\ AS A CATHODE MATERIAL OF LITHIUM SECONDARY BATTERIES \\$

竹内優作

Yusaku TAKEUCHI 指導教員 栗山一男

法政大学大学院理工学研究科電気電子工学専攻修士課程

The structure of Li_5SiN_3 is closely related to the antifluorite type Li_3AlN_2 . The structure of Li_3AlN_2 is essentially attributed to the six ionic Li-N bonds in the sublattice. In Li_3AlN_2 , Li and Al cations occupy 3/4 and 1/4 of tetrahedral holes of the N sublattice. In Li_5SiN_3 , 1/3 of the equivalent tetrahedral Al positions (16c) in Li_3AlN_2 are substituted by Li and Si atoms, therefore occupy the remaining 2/3 of these positions. Li_5SiN_3 crystals are synthesized by direct reaction between Li_3N and Si_3N_4 with the molar ratio $Li_3N : Si_3N_4$ of 10 : 1. Reaction is performed at 1073 K for 1h under a nitrogen atmosphere of 700 Torr. The lattice constant is 4.718Å determined by the X-ray powder diffraction method. The band gap of Li_5SiN_3 was found to be direct gap of about 2.5 eV by optical absorption and photoacoustic spectroscopy methods. The 5×5 mm² sized lithium secondary battery of Li_5SiN_3 cathode / propylene carbonate + $LiClO_4$ electrolyte / Li anode structure shows a discharge capacity of 2.4μ Ah/cm² for a discharge current of 1.0μ A.

Key Words : Li₅SiN₃, electro properties ,lithium secondary battery

1. 序論

充電可能なリチウムイオン電池は、高出力、高いエネ ルギー密度を有しているため、携帯用電気機器、電気自 動車やハイブリッド自動車用のエネルギー貯蔵技術とし て最も有望であると言われている。近年、安全性を確保 しつつさらなる高性能化、低コスト化が求められている。 コストの削減には電池を構成する材料のなかで、リチウ ムイオン供給源の役割を担う正極材料が最も高価なもの の一つであるため、より安価な材料の開発が求められる。 それと同時に電池の容量や作動電圧を決める重要な役割 も担っているため、電池の高性能化、低コスト化には正 極材料のさらなる研究が必要不可欠である。オンチップ バッテリーとして回路に電力を供給する電池の正極材料 として、LiMn₂0₄やLiCoO₂[1-4]などが有望視されており、 著者の研究室でも以前にこれらの材料の d-d 遷移エネル ギーがそれぞれ 1.63~2.10 eV[5,6] であると明らかにし た。それらを基に、2.0 eV 付近のバンドギャップを有す るリチウム三元化合物は正極材料に適しているのではな いかと推測した。現在リチウム二次電池の正極材料とし て多く用いられている LiCoO2 は合成が比較的容易であり、 なおかつ高い作動電圧と優れたサイクル特性を有する一 方で、Coに対してコスト面と安全面での懸念がもたれている。

本研究では、Coより安価で安全性の高いSiを含むリチ ウム三元化合物であるLi₅SiN₃に注目し、Li₅SiN₃の結晶作 製を行い、粉末X線回折法、光吸収法、光音響分光法、 ラマン分光法により基礎物性を評価し、ラザフォード後 方散乱測定(RBS)により組成比を決定した。また、Li₅SiN₃ を正極材料として用いたリチウム二次電池を作製し、そ の可能性を追求した。

Li₅SiN₃結晶作成および物性評価 (1)結晶作成

Li_sSiN₃はLi₃N 粉末(純度 99.5%)とSi₃N₄粉末(純度 99.99%)を分子量比 10:1に計量し、粉末状態で混合 したものを Ta 製のるぼに挿入後、ステンレス製真空チャ ンバー内の縦型抵抗電気炉内に設置し、10⁻² Torr になる まで真空排気を行った。その後、700 Torr の N₂雰囲気中 で 1073 K、1時間の熱処理により作製した。Ta 製のるつ ぼは予めアセトンで5分、メタノールで5分の有機洗浄

を行った。

(2) 粉末 X 線回折評価

作成した Li₅SiN₃結晶を X 線回折 (X-ray Diffraction : XRD) 法により評価した。図 1 に Li₅SiN₃の X 線回折パター ンを示した。図 1 の X 線回折パターンと JCPDS (Joint Committee for Powder Diffraction Standards) カード[5] を比較した結果、作成した Li₅SiN₃ 結晶は格子定数 a = 4.718 Åの単一相であると同定した。この値は報告され ている Li₈SiN₄ の格子定数 (a = 4.724Å[6]) と近い値を 示した。



図1 Li₅SiN₃の粉末 X 線回折パターン

(3) レーザラマン分光法による結晶構造の評価

作製した Li_sSiN_4 は、4本のラマンスペクトルが 196 cm⁻¹、 286 cm⁻¹、580 cm⁻¹、750 cm⁻¹に観測された。図 2 に Li_sSiN_4 のラマンスペクトルを示した。Li 原子と Mg 原子の不規則 構造を有している LiMgN (Space Group: Fm3m)のラマンス ペクトル[7]との比較より、580 cm⁻¹付近のラマンスペク トルは半値幅 150 cm⁻¹ を有しており、LiMgN と同様に Li 原子と Si 原子の不規則構造に起因していると考えられる。



図2 Li₅SiN₃のラマンスペクトル

(4) 光音響分光法によるバンドギャップの評価

光音響分光法 (Photoacoustic Spectroscopy : PAS) に よりバンドギャップの評価を行った。図3にGaP と Li₅SiN₃の PAS スペクトルを示した。GaP の PA シグナルは 540 nm (2.29 eV) から急激に増加しており、GaP のバンド ギャップ (Eg = 2.27 eV) に相当する。Li₅SiN₃の PA シグ ナルは 490 nm (2.53 eV) 付近から急激に増加している。 GaP の PAS 測定結果との比較より、Li₅SiN₃のバンドギャ ップは 2.53 eV 付近であると考えられる。



図3 Li₅SiN₃の PAS スペクトル

(5) 光吸収測定法によるバンドギャップの評価およ び遷移型の判別

Li_sSiN₄の遷移型を明らかにするため光吸収法を用い て評価した。図4にLi₅SiN₃の透過率スペクトルを示した。



図4 Li₅SiN₃の透過率スペクトル

なお、吸収係数は以下の(1)式[7]により示される。

$$\alpha = 1 / (t_1 - t_2) \cdot \ln T_2 / T_1$$
 (1)

試料の厚さを t₁、t₂と変えたときの透過率をそれぞれ

 T_1 、 T_2 として吸収係数 α を算出する。図4より、試料厚 さが0.116 mm (実線) および0.101 mm (破線) のときの 吸収係数 α を算出したところ、 α は最大で 100 cm⁻¹ 程度 であった。

バンドギャップの値および遷移型を同定するために以 下に述べる2通りの場合を考察した。直接遷移型のバン ド構造の場合、吸収係数は光子エネルギーhv に対して以 下の式を用いた[7]。

$$\alpha h \nu = A (h \nu - Eg)^{1/2}$$
(2)

ここで、A は係数[cm⁻¹eV^{1/2}]、Eg はバンドギャップ[eV] である。また、間接遷移型のバンド構造の場合は以下の 式を用いた[7]。

$$\alpha h \nu = B(h \nu - Eg)^2$$
(3)

ここで、B は係数[cm⁻¹eV^{1/2}]、Eg はバンドギャップ[eV] である。Li₅SiN₃の吸収係数に対して、上記2種類のプロ ットを行ったところ両プロットとも線形性を示している が、図5に示す直接遷移型プロットの方が間接遷移型プ ロットに比べ広い線形性を示している。したがって Li₅SiN₃は直接遷移型の半導体である。この直線領域を外 挿することにより得られたバンドギャップは2.52 eV で あった。この値は図3の光吸収スペクトルと近い値を示 した。



図5 $\alpha h \nu$ vs. $h \nu$ (直接遷移型モデルプロット)

(6) RBS 測定による組成比の計算

ラザフォード後方散乱法(RBS)により組成比の計算 を行った。作製したLi₅SiN₃を粉末にしたものをプレス機 で固め、ペレット状にした試料のランダムスペクトルの 測定を行った。分析ビームとして加速エネルギー1.5 MeV の水素イオンを用い、散乱角は150°で測定を行った。 図5より、LiとSiとNのそれぞれのピーク散乱強度の比 を取り、以下の式[8]を用いて組成比を計算した。

$$\frac{N_{Li}}{N_{Si}} = \frac{H_{Li}}{H_{Si}} \times \frac{\sigma_{Si}}{\sigma_{Li}} \times \frac{[\varepsilon]_{Li}^{Li_5SiN_3}}{[\varepsilon]_{Si}^{Li_5SiN_3}}$$
(4)

$$\frac{N_{N}}{N_{Si}} = \frac{H_{N}}{H_{Si}} \times \frac{\sigma_{Si}}{\sigma_{N}} \times \frac{[\epsilon]_{N}^{Li_{5}SiN_{3}}}{[\epsilon]_{Si}^{Li_{5}SiN_{3}}}$$
(5)

計算より、Li_{8.07}SiN_{2.90}であり、Li の量が多く出る結果 となった。



図 6 Li₅SiN₃ (powder) のランダムスペクトル

3. Li₅SiN₃を用いたリチウム二次電池特性の評価

Li_sSiN₃を乳鉢を用いて粉末状にし、プレス機を用いて 固め、5 × 5 mm²に成形したものを正極活物質として使 用した。電解質は PC (炭酸プロピレン)に 0.1 mol/L の割 合で LiClO₄ (過塩素酸リチウム)を混合し、グラスウー ルに染み込ませたものを使用した。負極にはリチウム金 属を使用した。測定は Ar 雰囲気中のグローブバッグ内で 行った。充放電特性を図 7、8 に示した。



図7 Li / PC+LiClO₄ / Li₅SiN₃ / Au構造の 充電特性



図 8 Li / PC+LiClO₄ / Li₅SiN₃ / Au 構造の 放電特性

放電容量は1.87 μAh/cm²から2.24 μAh/cm²であった。 1サイクル目と5サイクル目は2サイクル目から4サイク ル目と比較して放電容量は低かった。1サイクル目は、正 極と電解質の間でLiイオンの受け渡しがうまく行われな かったため、電圧降下が比較的早く、放電容量が低くな ったと考えられる。5サイクル目は充放電を繰り返すこと で、作成したLi₅SiN₃の結晶構造に変化が見られたためで はないかと考えられる。

4. 結論

Li₃N 粉末とSi₃N₄粉末の混合物を窒素雰囲気中で1073 K、 1 時間の熱処理を行うことで作成した。作成した Li₅SiN₃ は淡黄色を呈しており、単一相であると同定した。粉末 X 線回折法より JCPDS カード[5]で報告されている Li₅SiN₃ のピークとほぼ一致していることを確認した。格子定数 も a = 4.718 Åであり、JCPDS カード[5]で報告されてい る値 a = 4.724 Åとほぼ一致した値となった。

レーザーラマン分光法より、Li_sSiN₃は 196、286、580、 750 cm⁻¹にそれぞれラマン散乱ピークが観測された。580 cm⁻¹のブロードなピークの半値幅は約 150 cm⁻¹を有してお り、LiMnN(逆蛍石型)のラマンスペクトルとの類推によ りLi と Si による不規則構造に起因すると考えられる。

光音響分光法(PAS)、光吸収法よりLi_sSiN₃は2.5 eVの バンドギャップを有する直接遷移型の半導体であると同 定した。また、Li₃AlN₂のイオン度と比較してもイオン性 は小さい。Li₅SiN₃のバンドギャップ値は、LiMn₂O₄中のMn の d-d 遷移のエネルギーよりもやや大きい。

RBSを用いて組成比を計算するとLi_{8.07}SiN_{2.90}であり、 Li が多く出る結果となった。一方でGaNの組成比のズレ はほとんど見られなかった。Ga、N原子はH⁺に対して重元 素であるため組成比のズレは小さく、Li 原子はH⁺に対し て軽元素であるため組成比のズレは大きくなると考えら れる。また試料の酸化が原因のひとつとして考えられる。

充放電特性より、Li₅SiN₃正極はおよそ 3.8 V の充電電 圧を有していた。放電容量は最大で 2.27 μ Ah/cm⁻¹を有 していたが、5 サイクル目は放電容量が下がってしまい、 電池としての性能が低下してしまった。

謝辞: 本研究を行うにあたり、ご指導頂きました本 大学院理工学研究科 電気電子工学専攻 栗山一男教授 に深く感謝致します。学部生、大学院修士1年の頃に本 研究の基礎や実験手法に関して多くを指導していただき ました山下大輝氏(現東海旅客鉄道株式会社)に感謝致し ます。最後に多くのご助言、ご協力を頂いた本大学院理 工学研究科 電気電子工学専攻 栗山研究室の諸氏に感 謝致します。

参考文献

- 1) F. K. Shokoohi, J. M. Tarascon, and B. J. Wilkens, Appl. Phys. Lett. 59, 1260 (1991).
- B. Wang, J. B. Bates, F. X. Hart, B. C. Sales, R. A. Zuhr, and J. D. Robertson, J. Electrochem. Soc. 143, 3203 (1996).
- K. Kushida, K. Kuriyama, and T. Nozaki, Appl. Phys. Lett. 81, 5066 (2002).
- Y. Yamada, T. Nozaki, K. Kuriyama, and K. Kushida, J. Alloys and Compounds 551, 44 (2013).
- 5) JCPDS(No. 40-1446).
- Nuria Tapia-Ruiz, Marc Segalés, Duncan H.Gregory, Coordination Chemistry Reviews, 257, 1978 (2013).
- K. Kushida, Y. Kaneko, and K. Kuriyama, Phys. Rev. B70, 233303 (2004).
- W.-Kan Chu, J. W. Mayer, and M.-A. Nicolet, Backscattering Spectrometry (Academic, New York, 1978), Chap.5.